

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

ПРОТОКОЛ
заседания экспертной комиссии

от "26" ноября 2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

4 чел. (явочный лист прилагается).

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА:

Защита диссертации Султанова Азрета Оюсовича на тему «Закономерности роста эпитаксиальных пленок β -SiC на кремнии с нанопористым буферным слоем и исследование их физических свойств», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников.

Диссертация принята к защите Диссертационным советом НИТУ «МИСиС» 16.09.2019, протокол № 11.

Диссертация выполнена на кафедре «Физика конденсированных сред» Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ.

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор кафедры «Физика конденсированных сред» Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ, Сафаралиев Гаджимет Керимович.

Научный консультант: к.ф.-м.н., заместитель директора Института функциональной ядерной электроники НИЯУ МИФИ Гусев Александр Сергеевич

Экспертная комиссия:

1. Костишин Владимир Григорьевич, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой технологии материалов электроники НИТУ «МИСиС» – председатель комиссии;
2. Ховайло Владимир Васильевич, доцент, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС»;

3. Мурашев Виктор Николаевич, профессор, доктор технических наук, профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС»;
4. Тимошенко Виктор Юрьевич, профессор, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики низких температур и сверхпроводимости, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
5. Лебедев Александр Александрович, профессор, доктор физико-математических наук, руководитель отделения твердотельной электроники Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе.

Ведущее предприятие: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).

1. СЛУШАЛИ:

- доклад Султанова А.О. об основных положениях диссертации;
- вопросы соискателю и его ответы;
- выступление научного руководителя соискателя;
- отзыв ведущей организации и отзывы на диссертацию и автореферат, поступившие в диссертационный совет;
- отзывы членов экспертной комиссии;
- ответы соискателя на замечания, содержащиеся в отзывах;
- выступления членов экспертной комиссии и присутствующих в общей дискуссии по рассматриваемой работе.

2. Для проведения тайного голосования

роздано бюллетеней 4

осталось нерозданных бюллетеней 1

оказалось в урне бюллетеней 4

Результаты голосования по вопросу возможности присуждения Султанову Азрету Оюсовичу ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников.

«за» - 4;

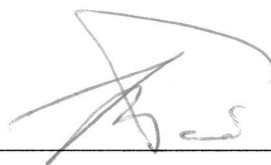
«против» - 0;

недействительных бюллетеней – 0.

На основании результатов тайного голосования экспертная комиссия приняла решение о возможности/невозможности (ненужное вычеркнуть) присуждения Султанову Азрету Оюсовичу ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников.

3. Рассмотрение и принятие открытым голосованием заключения экспертной комиссии по диссертации Султанова А.О. Заключение комиссии принято единогласно.

председатель комиссии д.ф.-м.н. Костишин В.Г.



член комиссии д.ф.-м.н. Ховайло В.В.



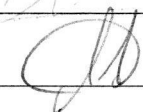
член комиссии д.т.н. Мурашев В.Н.



член комиссии д.ф.-м.н. Тимошенко В.Ю.

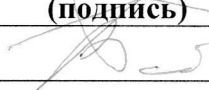
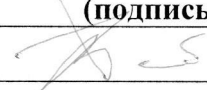
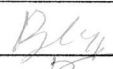
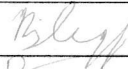
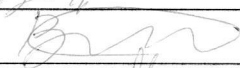
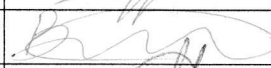

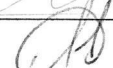


член комиссии д.ф.-м.н. Лебедев А.А.



ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов экспертной комиссии к заседанию от **26.11.2019 г.** по защите кандидатской
диссертации **Султанова Азрета Оюсовича**
на тему «Закономерности роста эпитаксиальных пленок β -SiC на кремнии с нанопористым
буферным слоем и исследование их физических свойств»
по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников

№	Фамилия	Явка на заседание (подпись)	Получение бюллетеня (подпись)
1	Костишин Владимир Григорьевич		
2	Ховайло Владимир Васильевич		
3	Мурашев Виктор Николаевич		
4	Тимошенко Виктор Юрьевич		
5	Лебедев Александр Александрович		

Председатель комиссии
д.ф.-м.н.



Костишин В.Г.